

## 富士IGBTモジュール『Nシリーズ』7MBR30NF060

低損失・高速スイッチング形『Nシリーズ』

600V/30A/PIM

## ■特長：Features

- 高速スイッチング High Speed Switching
- 電圧駆動 Voltage Drive
- 低インダクタンスモジュール構造  
Low Inductance Module Structure
- コンバータダイオードブリッジ・ダイナミックブレーキ回路内蔵  
Converter Diode Bridge Dynamic Brake Circuit

## ■用途：Applications

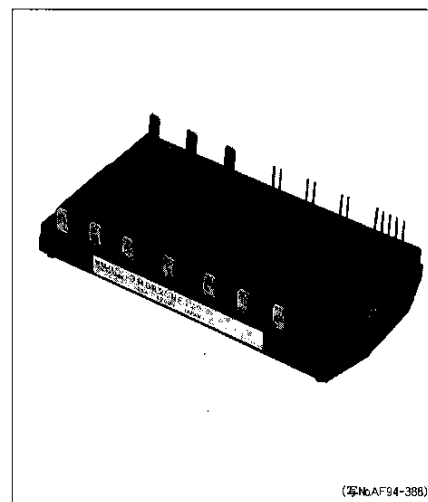
- モータ駆動用インバータ Inverter for Motor Drive
- AC,DCサーボアンプ AC and DC Servo Drive Amplifier
- 無停電電源 Uninterruptible Power Supply

## ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C)

	Items	Symbols	Condition	Ratings	Units	
インバータ部(IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEs</sub>		600	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V <sub>GES</sub>		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I <sub>c</sub>		30	A
		1ms	I <sub>c pulse</sub>		60	
		最大損失	P <sub>c</sub>		120	W
ブレーキ部(IGBT-FWD) BRAKE	コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEs</sub>		600	V	
	ゲート・エミッタ間電圧	V <sub>GES</sub>		±20	V	
	コレクタ電流	DC	I <sub>c</sub>		30	A
		1ms	I <sub>c Pulse</sub>		60	A
		最大損失	P <sub>c</sub>		120	W
		ピーク繰返し逆電圧	V <sub>RRM</sub>		600	V
		平均順電流	I <sub>F (AV)</sub>		1	A
	サージ電流	I <sub>FSM</sub>	10ms	50	A	
コンバータ部(Diode) Converter	ピーク繰返し逆電圧	V <sub>RRM</sub>		800	V	
	ピーク非繰返し逆電圧	V <sub>RSM</sub>		900	V	
	平均出力電流	I <sub>o</sub>	50/60HZ 正弦波	50	A	
	定格サージ電流 (非繰返し)	I <sub>FSM</sub>	T <sub>j</sub> =150°C 10ms	350	A	
	定格I <sup>2</sup> t (非繰返し)		T <sub>j</sub> =150°C 10ms	648	A <sup>2</sup> s	
	接合部温度	T <sub>j</sub>		+150	°C	
	保存温度	T <sub>stg</sub>		-40~+125	°C	
	絶縁耐圧	V <sub>iso</sub>	AC: 1min.	AC2500	V	
	締付けトルク	Mounting*1		1.7	N・m	

\*1 推奨値：Recommendable value：1.3~1.7 N・m



(7MBR30NF060)

●電気的特性 : Electrical Characteristics (T<sub>J</sub>=25°C)

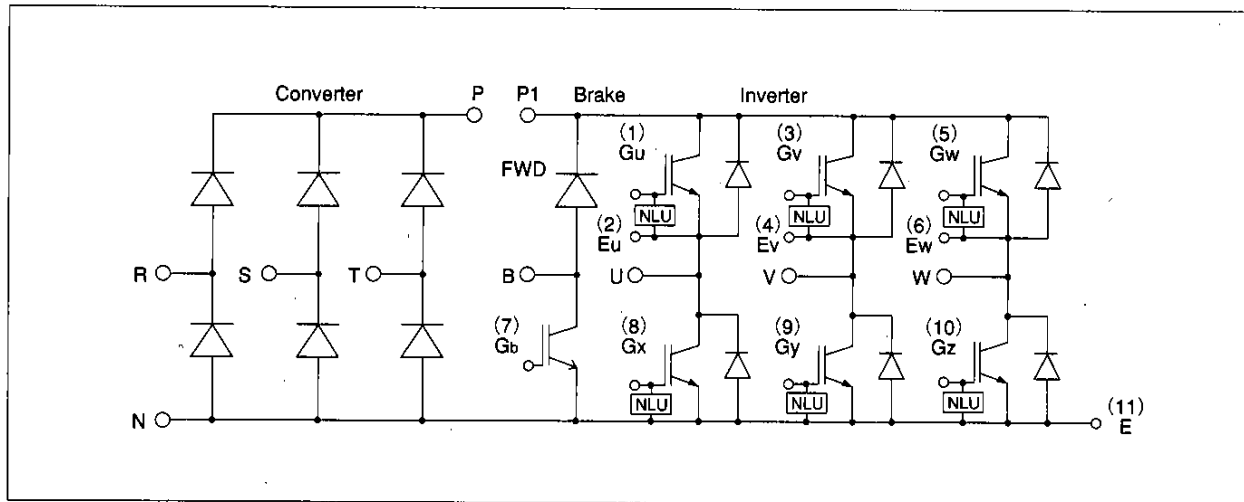
Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units
			min.	typ.	max.	
インバータ部 (IGBT) INVERTER	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I <sub>CES</sub>	V <sub>CE</sub> =600V, V <sub>GE</sub> =0V		1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I <sub>GES</sub>	V <sub>CE</sub> =0V, V <sub>GE</sub> =±20V		20	μA
	ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V <sub>GE(th)</sub>	V <sub>CE</sub> =20V, I <sub>C</sub> =30mA	4.5	7.5	V
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	V <sub>GE</sub> =15V, I <sub>C</sub> =30A		2.8	V
	コレクタ・エミッタ間電圧	-V <sub>CE</sub>	-I <sub>C</sub> =30A		3.0	V
	入力容量	C <sub>ies</sub>	V <sub>GE</sub> =0V, V <sub>CE</sub> =10V, f=1MHz		1980	PF
	スイッチング時間	ton	V <sub>CC</sub> =300V I <sub>C</sub> =30A		1.2	μs
		tr	V <sub>GE</sub> =±15V		0.6	
		toff	R <sub>G</sub> =82Ω		1.5	
		tf			0.35	
逆回復時間	trr	I <sub>F</sub> =30A, V <sub>GE</sub> =-10V, -di/dt=100A/μs		300	ns	
ブレーキ部 (IGBT) BRAKE (IGBT)	コレクタ・エミッタ間遮断電流	I <sub>CES</sub>	V <sub>CE</sub> =600V, V <sub>GE</sub> =0V		1.0	mA
	ゲート・エミッタ間漏れ電流	I <sub>GES</sub>	V <sub>CE</sub> =0V, V <sub>GE</sub> =±20V		100	nA
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	V <sub>GE</sub> =15V, I <sub>C</sub> =30A		2.8	V
	スイッチング時間	ton	V <sub>CC</sub> =300V I <sub>C</sub> =30A		0.8	μs
		tr	V <sub>GE</sub> =±15V		0.6	
		toff	R <sub>G</sub> =82Ω		1.0	
		tf			0.35	
	逆電流	I <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub> =600V		1	mA
	逆回復時間	trr			600	ns
	コンバータ部 Converter	順電圧	V <sub>FM</sub>	I <sub>F</sub> =50A		1.55
逆電流		I <sub>RRM</sub>	V <sub>R</sub> =800V		1	mA

●熱的特性 : Thermal Characteristics

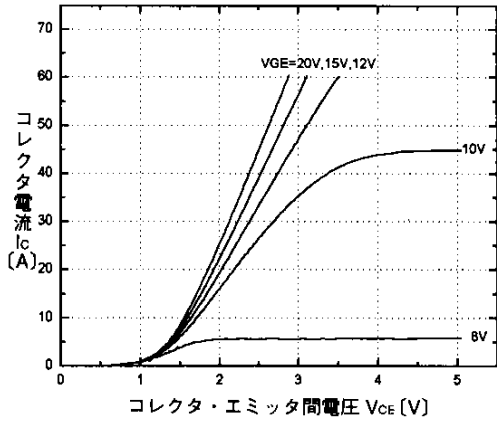
Items	Symbols	Conditions	Characteristics			Units
			min.	typ.	max.	
熱抵抗 (1chip)	R <sub>th(j-c)</sub>	Inverter IGBT			1.04	°C/W
		Inverter FRD			2.22	
		Brake IGBT			1.04	
		Converter Diode			2.1	
		接触熱抵抗 (ケース フィン間) ※	R <sub>th(c-f)</sub>	With Thermal Compound		

※サーマルコンパウンドを使用して放熱フィン上にモジュールを取り付けた時の接触熱抵抗値  
 ※This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound.

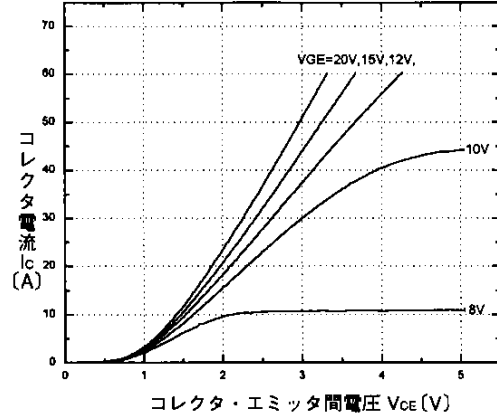
■等価回路 : Equivalent Circuit Schematic



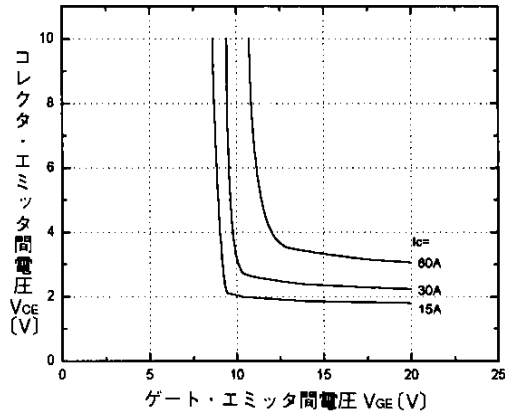
■特性曲線：Characteristics



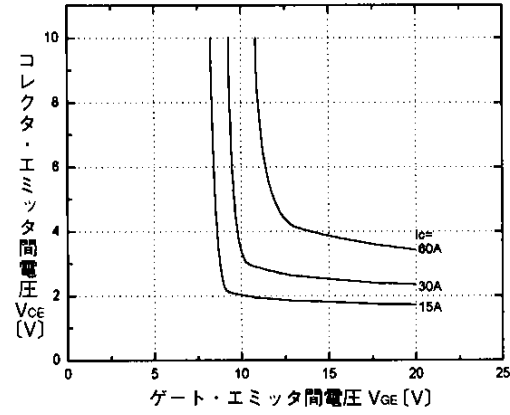
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>



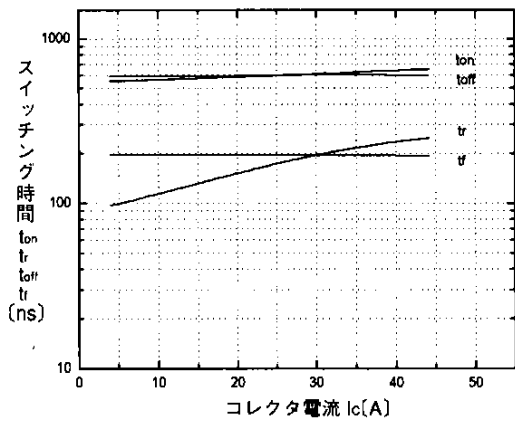
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <INV>



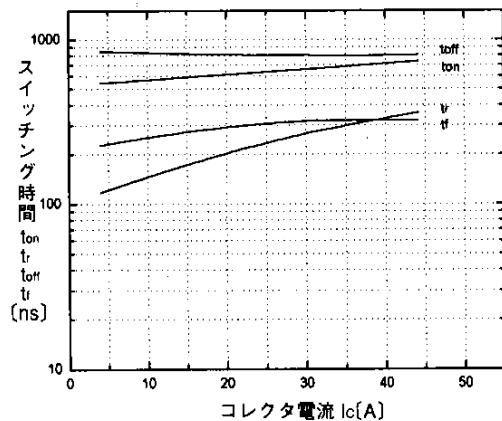
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>



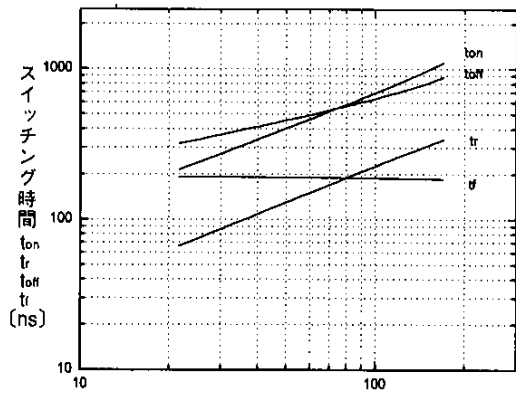
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <INV>



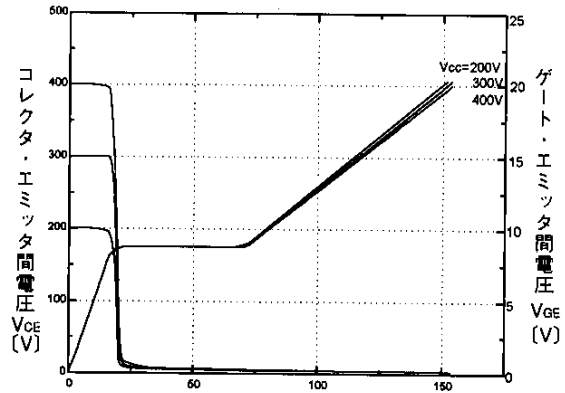
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Switching time vs. Collector current <INV>



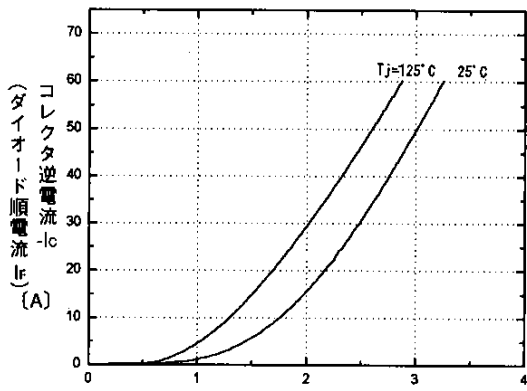
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Switching time vs. Collector current <INV>



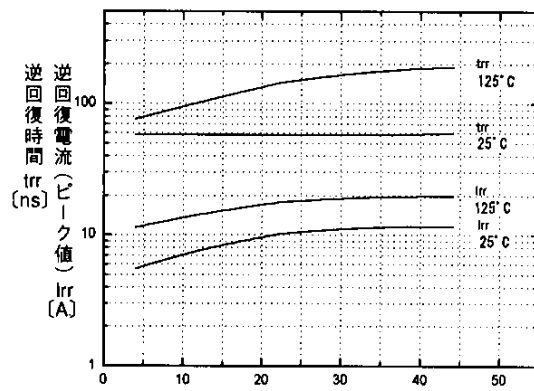
ゲート抵抗  $R_G(\Omega)$   
 スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
 Switching time vs. Gate resistance <INV>



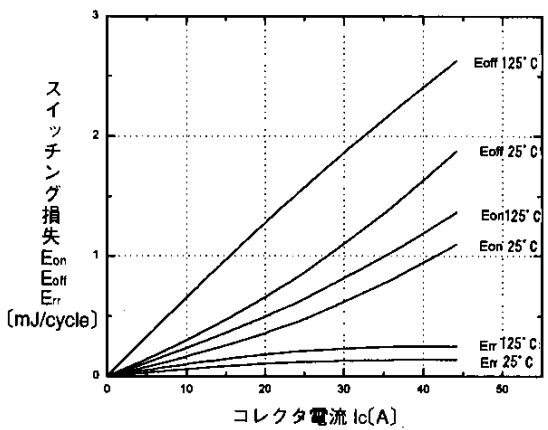
充電電荷量  $Q_g(\text{nC})$   
 ダイナミック入力特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
 Dynamic input characteristic <INV>



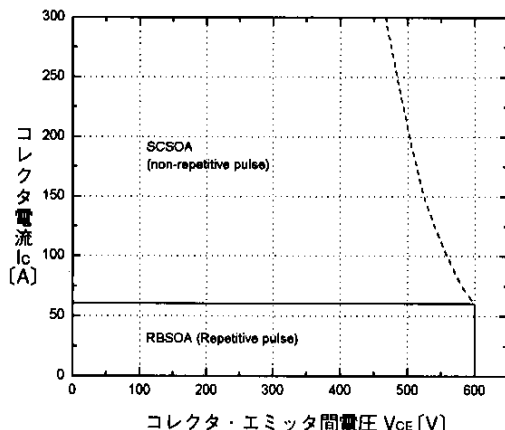
エミッタ・コレクタ間電圧  $V_{CE}(\text{V})$   
 (ダイオード順電圧  $V_F$ )  
 高速フリーホイールダイオード順電圧特性 <INV部>  
 Forward voltage of free wheel diode <INV>



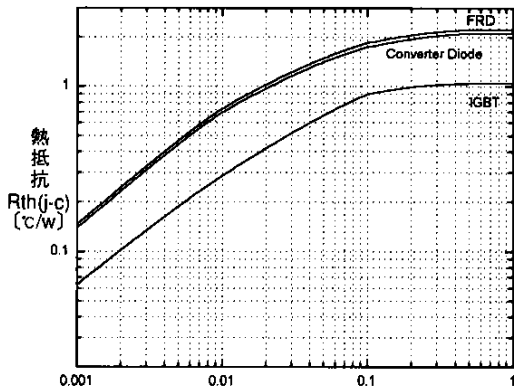
順電流  $I_F(\text{A})$   
 $T_{rr}, I_{rr}-I_F$  特性 <INV部>  
 $T_{rr}, I_{rr}-I_F$  <INV>



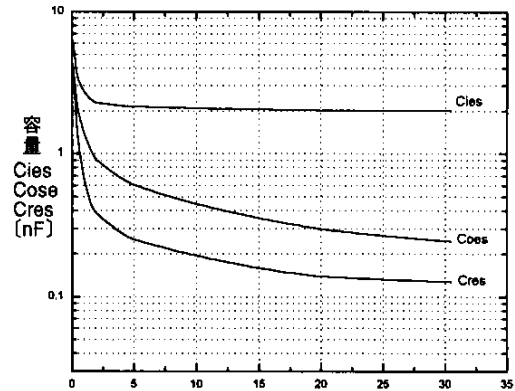
スイッチング損失-コレクタ電流特性 <INV部>  
 Switching loss vs. Collector current <INV>



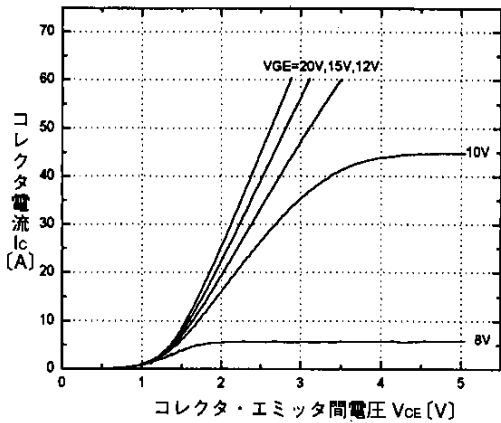
安全動作領域(逆バイアス) ( $T_j \leq 125^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
 Reverse biased safe operating area <INV>



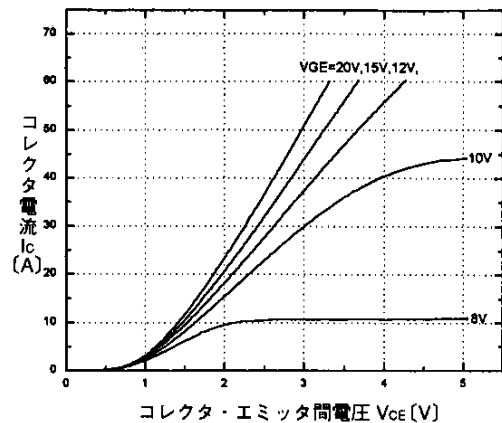
パルス幅  $P_w$  [S]  
過渡熱抵抗特性  
Transient thermal resistance



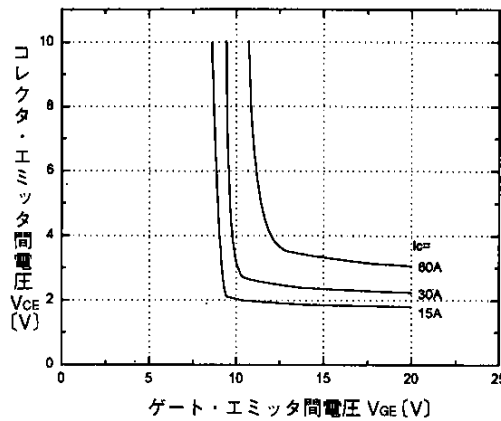
コレクタ・エミッタ間電圧  $V_{CE}$  [V]  
容量-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <INV部>  
Capacitance vs. Collector-Emitter voltage <INV>



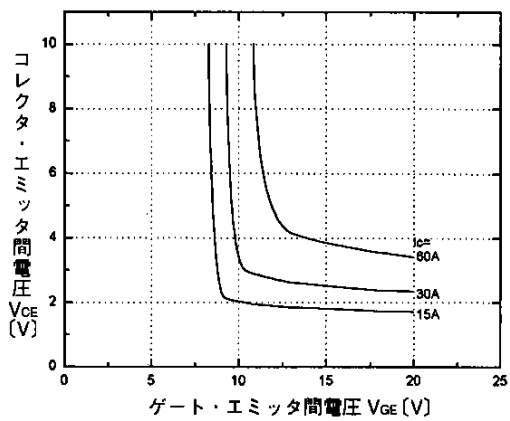
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>



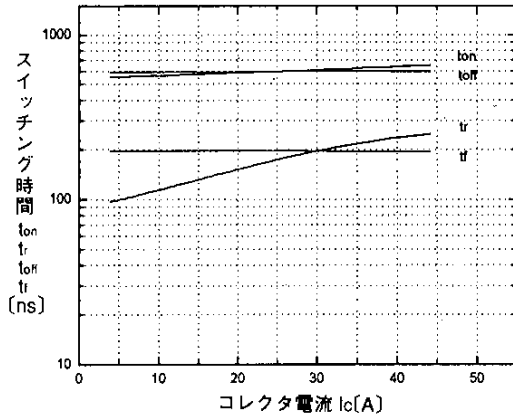
コレクタ電流-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Collector current vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>



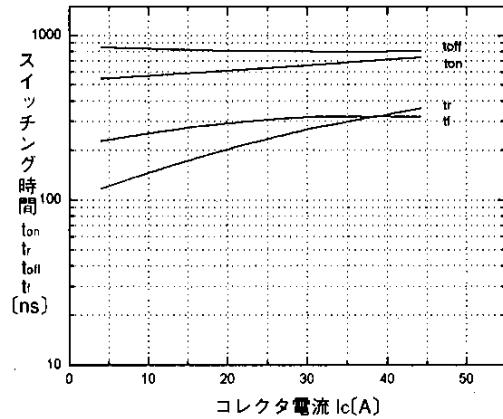
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>



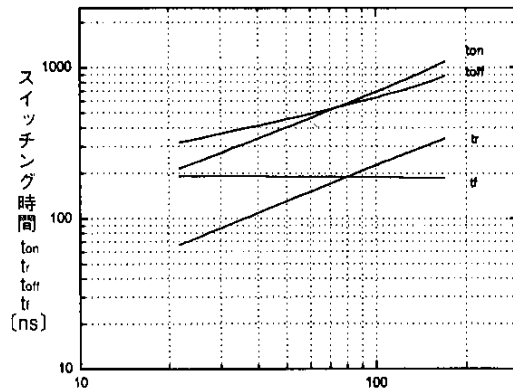
コレクタ・エミッタ間電圧-ゲート・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Collector-Emitter voltage vs. Gate-Emitter voltage <BRAKE>



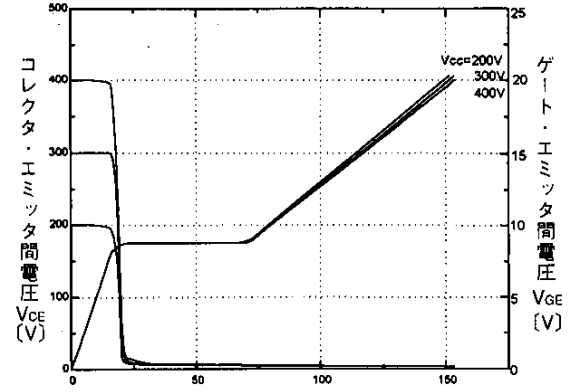
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Switching time vs. Collector current <BRAKE>



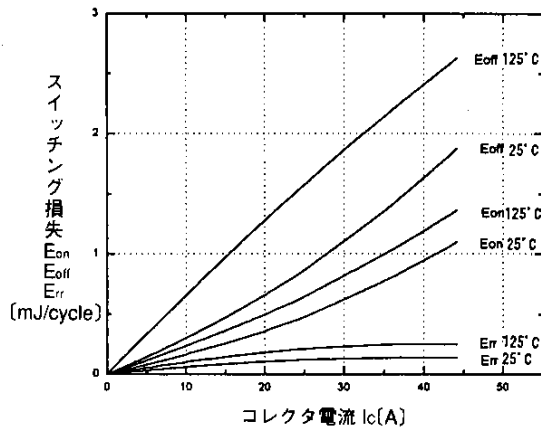
スイッチング時間-コレクタ電流特性 ( $T_j=125^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Switching time vs. Collector current <BRAKE>



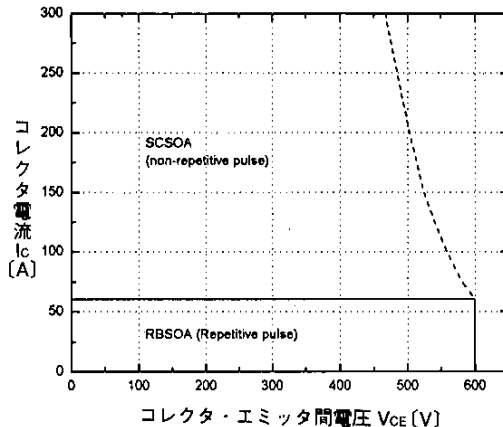
ゲート抵抗  $R_g$  ( $\Omega$ )  
スイッチング時間-ゲート抵抗特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Switching time vs. Gate resistance <BRAKE>



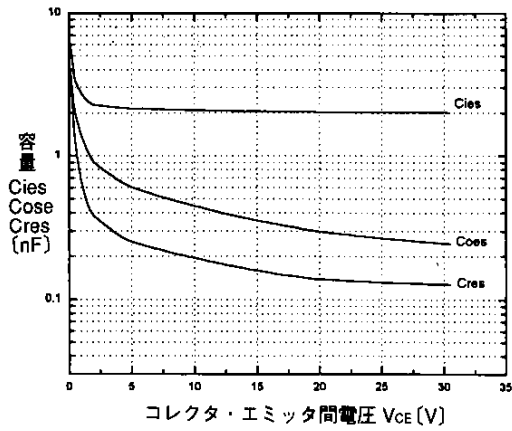
充電電荷量  $Q_g$  (nC)  
ダイナミック入力特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Dynamic input characteristic <BRAKE>



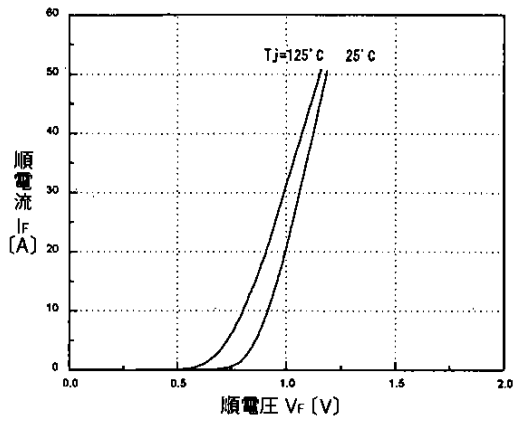
スイッチング損失-コレクタ電流特性 <ブレーキ部>  
Switching loss vs. Collector current <BRAKE>



安全動作領域(逆バイアス) ( $T_j \leq 125^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Reverse biased safe operating area <BRAKE>

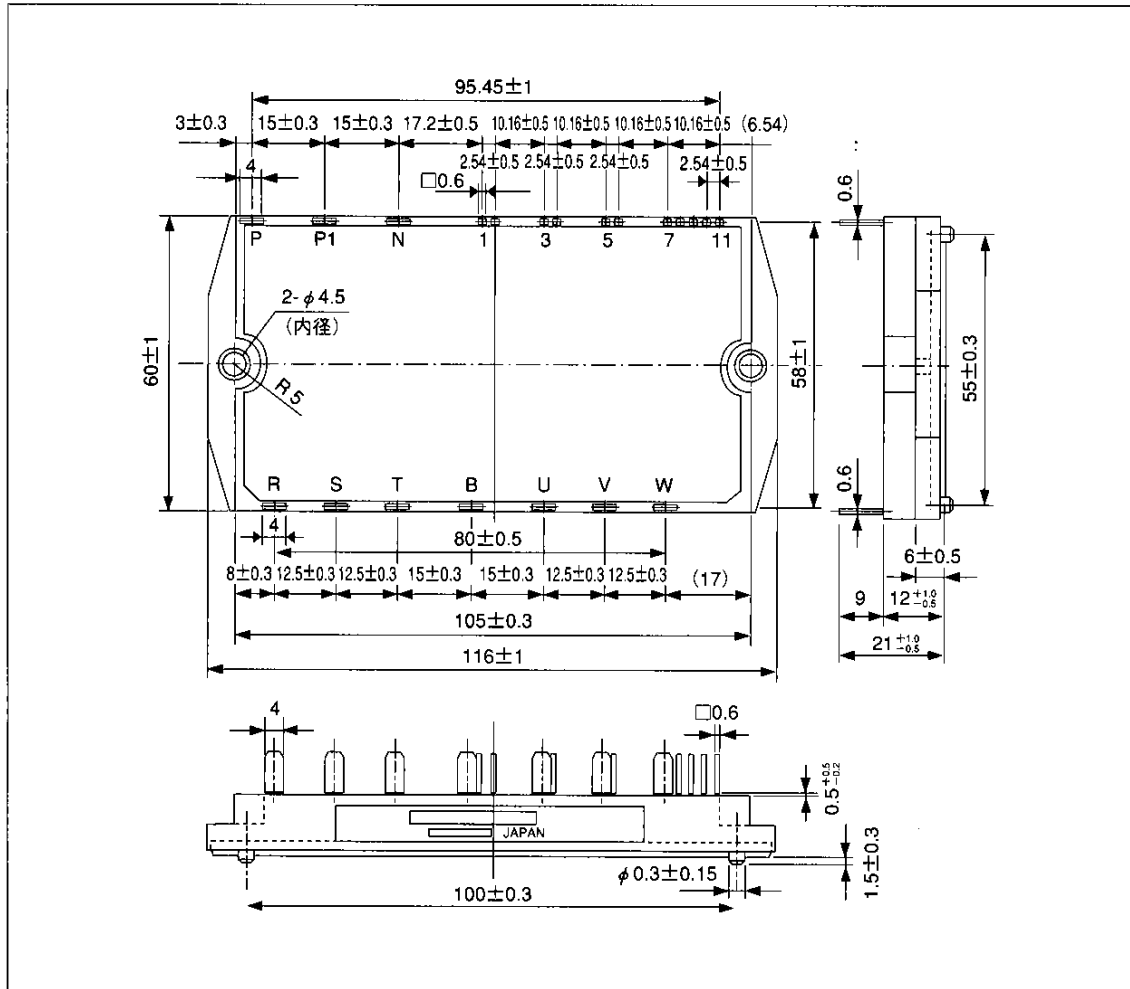


容量-コレクタ・エミッタ間電圧特性 ( $T_j=25^\circ\text{C}$ ) <ブレーキ部>  
Capacitance vs. Collector-Emitter voltage <BRAKE>



コンバータ部ダイオード順電圧特性  
Converter Diode  
Forward current vs. Forward voltage

■外形寸法：Outline Drawings



輸出に際してのお願い：本品のうちで、戦略物資（または役務）に該当するものを輸出される場合は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく輸出許可が必要です。

## 富士電機株式会社

電子事業本部・半導体事業部

☎ (03) 5388-7622  
(03) 5388-7651

〒100 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号  
(新宿コヤマビル)

営業統括部 (03) 5388-7657  
(03) 5388-7680  
長野電子営業課 (0263) 36-6740  
海外営業部 (03) 5388-7685

●支社  
北海道 (011) 271-3377  
東北 (022) 222-1110  
北陸 (0764) 41-1231  
中部 (052) 204-0295  
関西 (06) 455-6467  
中国 (082) 237-6992  
四国 (0878) 23-3110

九州 (092) 731-7111

●営業所  
浜松 (053) 485-0380